薄膜光学

# Sb,In,P掺杂对SnO2薄膜透明导电性能的影响

闫军锋<sup>1</sup>;张志勇<sup>2</sup>;赵武<sup>2</sup>;邓周虎<sup>2</sup>;王雪文<sup>2</sup>

西北大学 信息科学与技术学院, 西安 7100691

收稿日期 2007-3-22 修回日期 2007-4-12 网络版发布日期 2007-8-15 接受日期

采用溶胶凝胶(Sol-Gel)技术制备了Sn02:(Sb, In)透明导电薄膜,优化了制备工艺参数,获得了最佳制 ▶ 把本文推荐给朋友 备条件. 研究表明,4%的铟掺杂有效地改善了薄膜的内部结构,使得紫外-可见光的透过率显著增加;7%的锑掺杂 释放出了更多的载流子,使薄膜的方块电阻降低,2%的磷掺杂因准连续杂质能带的形成进一步提高了薄膜的电导 率. Sb、In、P的掺入使得Sn02薄膜的紫外-可见光的透过率达83%,方块电阻达 $38\Omega/\Box$ .

Sol-Gel 掺杂 二氧化锡 透明导电薄膜 关键词 分类号 0484.1

通讯作者 闫军锋 yanjf@nwu.edu.cn

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ **PDF**(301KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- ▶参考文献

## 服务与反馈

- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶复制索引
- ▶ Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶浏览反馈信息

#### 相关信息

- ▶ 本刊中 包含 "Sol-Gel" 的 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- 闫军锋
- 张志勇
- 赵武
- 邓周虎
- 王雪文